

# Panier De Nettoyage Pour Wafers En Ptfé Haute Pureté, Résistant Aux Acides, Porteur De Wafers En Silicium, Rack De Gravure En Fluoropolymère

Numéro d'article: PL-CP284



## Introduction

Assurez un traitement de semi-conducteurs sans contamination avec nos paniers de nettoyage pour wafers en PTFE haute pureté. Conçus pour la gravure et le nettoyage agressifs, ces porteurs personnalisables offrent une résistance chimique exceptionnelle et une stabilité thermique pour la manipulation de wafers en silicium lors des processus de fabrication chimique humide critiques.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage Clé
<b>Nettoyage Standard RCA</b>	Étapes de nettoyage séquentiel SC-1 et SC-2 pour éliminer les résidus organiques et les contaminants métalliques des wafers de silicium.	Empêche le lessivage d'ions métalliques, garantissant des environnements de traitement ultra-purs.
<b>Gravure Piranha</b>	Utilisation de mélanges d'acide sulfurique et de peroxyde d'hydrogène pour éliminer les matériaux organiques lourds et la résine photosensible.	Résiste aux réactions exothermiques extrêmes et à l'oxydation agressive sans dégradation.
<b>Trempe/Gravure HF</b>	Élimination des couches d'oxyde sacrificielles ou des oxydes natifs à l'aide de solutions d'acide fluorhydrique.	Immunité complète aux attaques HF, qui détruiraient les porteurs en verre ou en quartz.
<b>Texturation de Cellules Solaires</b>	Immersion de wafers de silicium dans des solutions alcalines ou acides pour créer des textures de surface piégeant la lumière.	Débit à grand volume et résistance aux solutions concentrées de KOH ou NaOH.
<b>Nettoyage Post-CMP</b>	Élimination des particules de boue et des résidus chimiques suite au polissage mécano-chimique.	La surface antiadhésive empêche le redépôt de boue sur le porteur et les wafers.
<b>Photolithographie</b>	Étapes de développement et de décapage impliquant des solvants organiques agressifs et des révélateurs.	La construction résistante aux solvants assure aucun gonflement ou ramollissement du matériau du porteur.
<b>Nettoyage Ultrasonique</b>	Nettoyage acoustique à haute fréquence de composants électroniques délicats dans des solutions aqueuses.	Transmet efficacement l'énergie ultrasonore tout en protégeant les composants des impacts mécaniques.
<b>Traitement GaAs</b>	Gravure et nettoyage chimique humide de substrats de semi-conducteurs composés pour l'optoélectronique.	Support doux et sécurisé pour les substrats fragiles lors des étapes de fabrication critiques.

Paramètre	Description / Spécification (Série PL-CP284)
<b>Numéro d'Article du Produit</b>	PL-CP284
<b>Matériau Principal</b>	PTFE Vierge Haute Pureté (Polytétrafluoroéthylène)
<b>Compatibilité Chimique</b>	Universelle (Acides Forts, Bases, Solvants, Oxydants)
<b>Tailles de Wafers Standard</b>	Compatible avec les wafers de 4 pouces, 6 pouces et 8 pouces
<b>Options de Personnalisation</b>	Dimensions, nombre de fentes et largeurs de fentes entièrement personnalisables

Application	Description	Avantage Clé
Paramètre	Description / Spécification (Série PL-CP284)	
<b>Configurations de Poignée</b>	Styles fixes, amovibles ou compatibles avec robots (Personnalisable)	
<b>Température de Fonctionnement</b>	-200°C à +260°C (Continu)	
<b>Finition de Surface</b>	Usiné par CNC de haute précision, surface à faible porosité	
<b>Conception de Fente</b>	Forme en V ou profils personnalisés pour une zone de contact minimale	
<b>Procédé de Fabrication</b>	100% Usiné par CNC pour la précision et l'intégrité structurelle	
<b>Niveau de Pureté</b>	Niveau d'analyse de traces, fabrication sans métal	